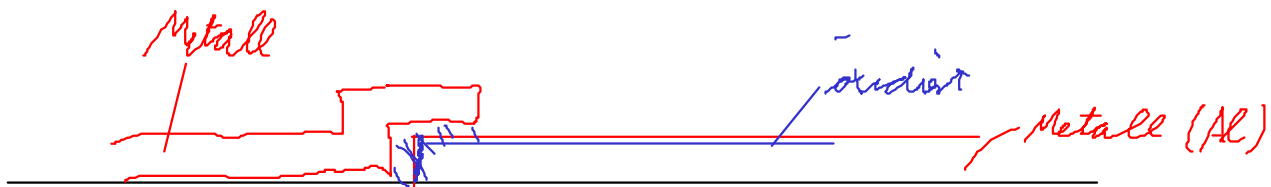


# 7 Einzel-Elektron-Effekt

## smallest-electron effect

### 7.7 Ladungsenergie

#### 7.7.1 Energieskala



Fläche zw.  $F = (30 \text{ nm})^2 \dots (100 \text{ nm})^2 \dots$

$\hat{=}$  Kapazität  $C = \frac{\epsilon F}{4\pi d}$

Fläche  
Abstand

$1 F = 9 \cdot 10^{21} \text{ cm}$

$d = 1 \text{ nm}$

$\epsilon = 10 \text{ (AlO)}$

$C = \frac{10 \cdot (10^2 \text{ nm})^2}{4\pi \cdot 1 \text{ nm}} \approx 10^4 \text{ nm} = 10^{-3} \text{ cm} = 10^{-15} \text{ F}$

$\approx 10$

$(1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} = 10^{-7} \text{ cm})$

vgl. Kapazität einer Kugel nach  $\infty$

$C = R$ , Bsp  $R = 10 \text{ nm}$

$C = 10^{-6} \text{ cm} = 10^{-18} \text{ F}$

Kap. mit Ladung  $Q \rightarrow$  Energie  $E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

kleinste Ladung  $Q = e$  1 Elektron

$\Rightarrow$  Energie  $E = \frac{1}{2} \frac{e^2}{C} = \frac{1}{2} e \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{10^{-15} \text{ F}} \approx 10^{-4} \text{ eV}$

Bsp  $\nearrow$

$10^{-4} \text{ eV}$  entspricht  $T \approx 1 \text{ K}$  ( $E = k_B T$ )

Bei  $T < 1K$  ist  $E_c$  eine wichtige Energie

bei  $T \gg 1K$  ist  $E_c$  vernachlässigbar  
(für diese Beispiel)

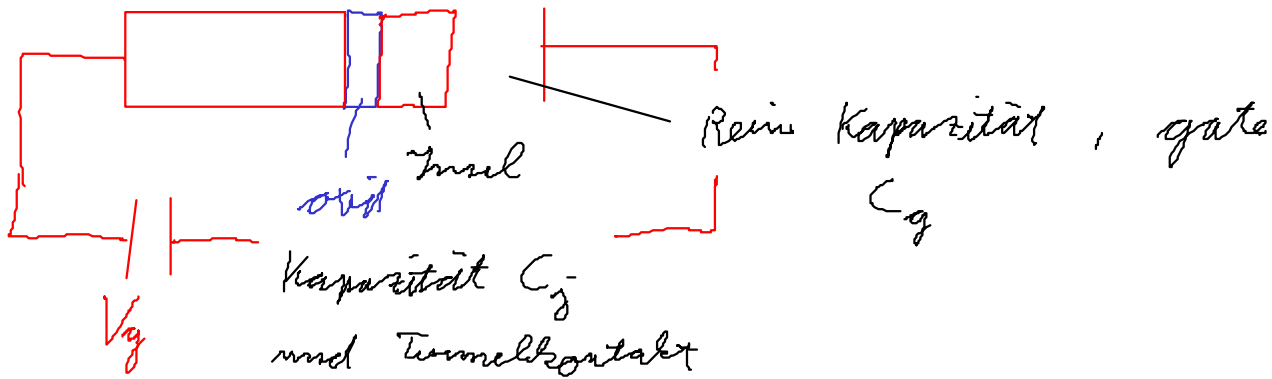
Aber für  $C = 10^{-18} F$  ist  $E_c \approx 10^{-7} eV$

$$\Rightarrow T \approx 10^3 K$$

$\Rightarrow$  Auch bei Raumtemp. wichtig

### 7.7.2 single - electron box

#### Einzel - Elektron - Schachtel



Über den Kontakt können Elektronen tunneln.

Als Ergebnis haben wir  $n$  Elektronen auf der Insel relativ zum Ladungsneutralen Ausgangszustand.

legt man eine Spannung an, kann man  $n \pm 1, \pm 2$  Elektronen auf der Insel haben.

Elektrostatistische Energie des Systems

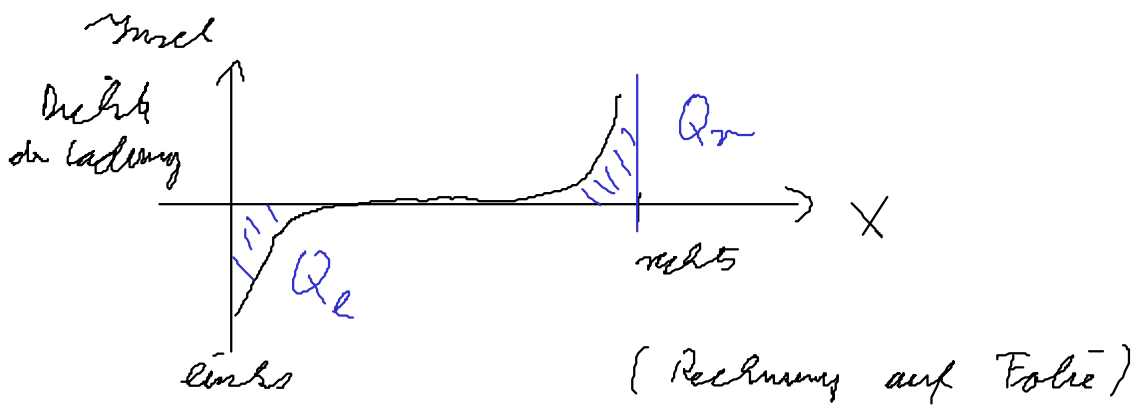
$$E_c = \frac{(ne - C_g V_g)^2}{2(C_j + C_g)}$$

$$Q_g = C_g V_g$$

$$C = C_j + C_g$$

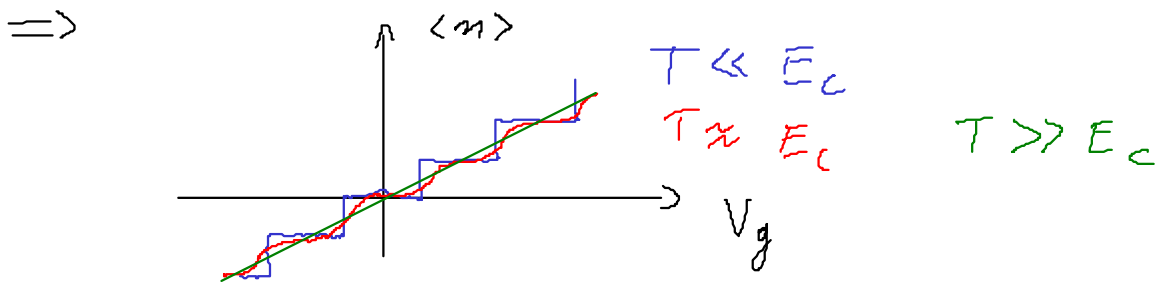
$$= \frac{(ne - Q_g)^2}{2C}$$

Elektronen mit Genauigkeit  $10^{-8}$  zählen



für endl. Temp.

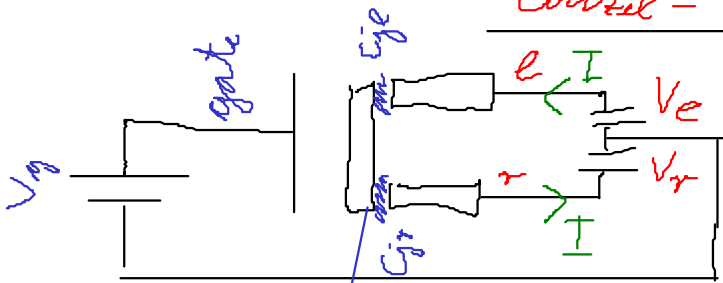
$$\langle n(Q_g) \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{n=-\infty}^{\infty} n e^{-\frac{E_n(n, Q_g)}{k_B T}}$$



typ. Temp. im Experiment  $T \geq 30 \text{ mK}$

## 7.2 Single-electron transistor SET

Einzel-Elektron Transistor



$$Q_g = C_g V_g + C_{je} V_e + C_{jr} V_r$$

$$C = C_g + C_{je} + C_{jr}$$

Elektrostatische Energie

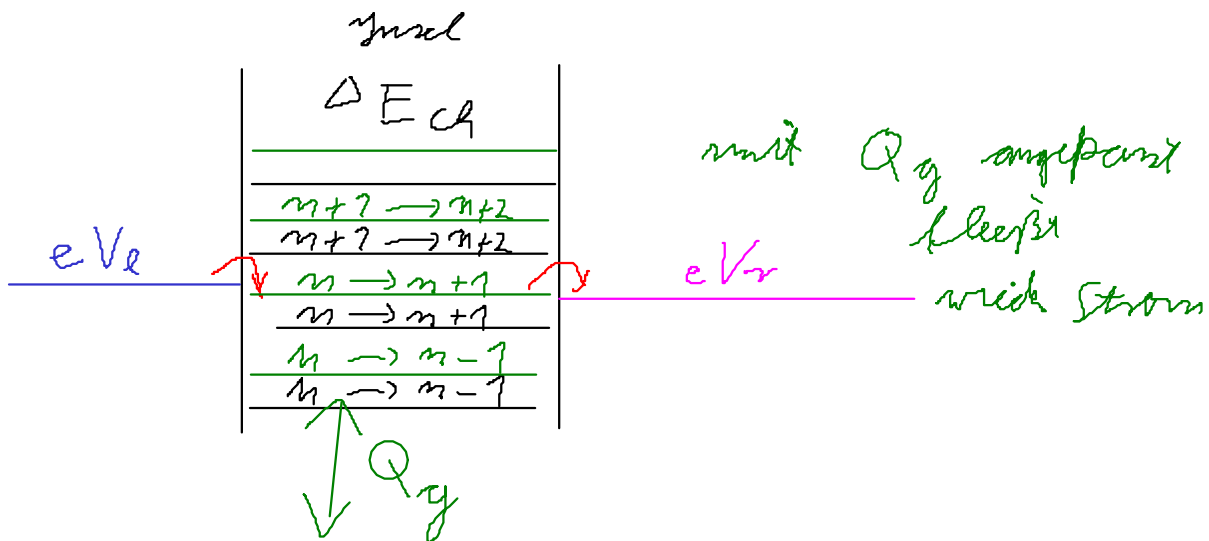
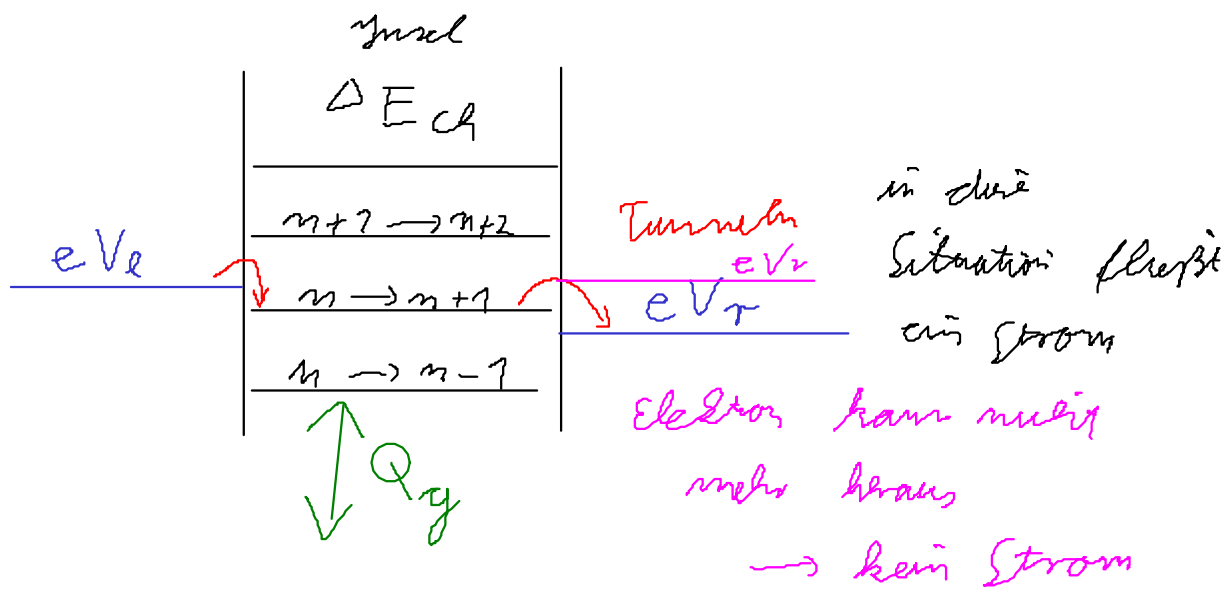
$$E_{ch}(n, Q_g) = \left( \frac{n_e - Q_g}{2C} \right)^2$$

Energieunterschied wenn ein Elektron tunnelt

$$n \rightarrow n+1$$

$$\begin{aligned} \Delta E_{Ch} (n \rightarrow n+1) &= E_{Ch} (n+1, Q_g) - E_{Ch} (n, Q_g) \\ &= \left( n + \frac{1}{2} - \frac{Q}{g} \right) \frac{e^2}{C} \end{aligned}$$

Tunneln ist energetisch günstig für Elektron von links, wenn  $E_{V_e} \geq E_{Ch} (n \rightarrow n+1)$   
 nach rechts  $E (n+1 \rightarrow n) \geq eV_r$



(Coulomb-blockade diamonds, Bild)